

InGaAs фотодиод 2600 нм, 1000 мкм, с однокаскадным ТЕС, ТО-корпус — техническое описание

P/N: WET5-1000B

ОСОБЕННОСТИ:

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–2600 нм

ПРИМЕНЕНИЕ:

Датчики СО; оптические датчики; измерители оптической мощности; измерение спектральной чувствительности

Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	D	-	995	1000	1005	мкм
Чувствительность	R	Vr=0V,@2300 nm	0.9	1.0	-	А/Вт
Темновой ток	ID	Vr=-0.5V	-	-	50	мкА
Спектральная чувствительность	λ	-	900	2330	2600	нм
Емкость	C	Vr=0V, f=1MHz		440	1000	пФ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.
Рабочая температура	TSTG	°C	-40	85
Температура хранения	TC	°C	-40	85
Температура (время) пайки	TL	°C		260 / 10 c

Тепловые параметры и параметры ТЕС

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Сопротивление термистора	Rt	T=25 °C	-	10	-	кОм
В-константа термистора	B	T=25 °C	-	3950	-	К
Ток ТЕС	Ic	-40~120 °C	-	-	2	А
Напряжение ТЕС	Vc	-40~120 °C	-	-	2.5	В

Назначение выводов и габаритный чертёж

